

99-0222

Изобретение относится к полупроводниковой фотографии и может быть использовано в голографии, микроэлектронике, при изготовлении микрофиш и т.д.

Сущность изобретения: на тонкослойной фоточувствительной структуре

SnO_2 - As_2Se_3 - Al получают изображение путем экспонирования. Одновременно к фоточувствительной структуре прикладывают электрическое поле, затем осуществляют обработку в растворе состава, г/л:

натрий углекислый безводный 50

хромат калия 15

дистиллированная вода остальное.